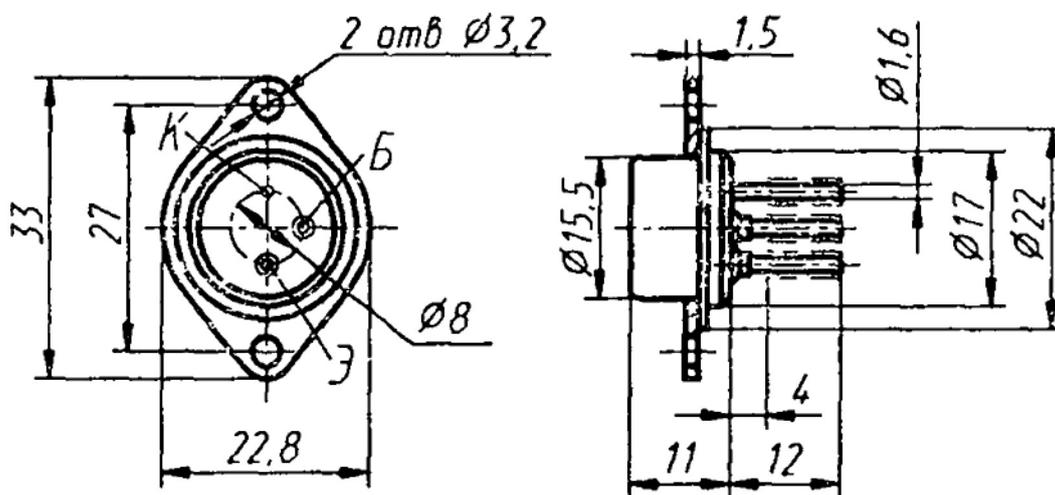


1Т906А, ГТ906А, ГТ906АМ

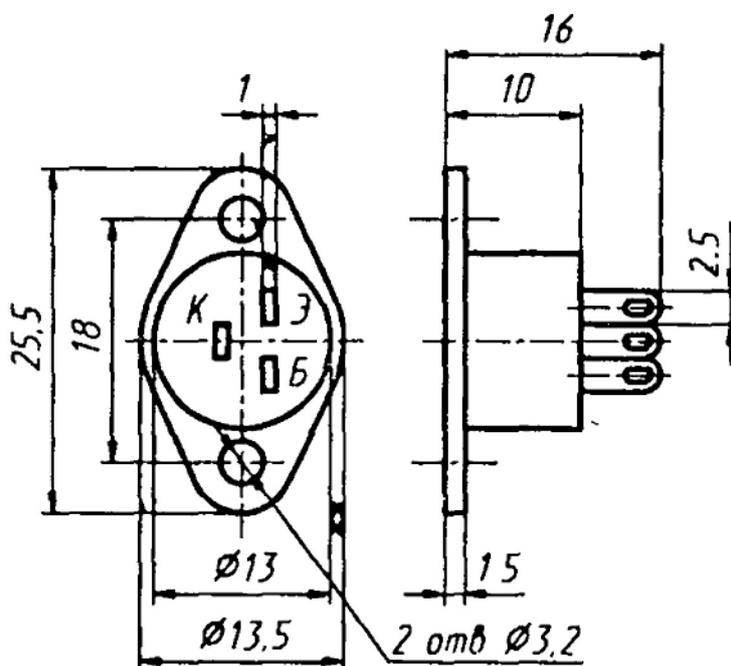
Транзисторы германиевые диффузионно-сплавные структуры *p-n-p* переключательные. Предназначены для применения в преобразователях напряжения, переключающих и импульсных усилительных каскадах радиозлектронных устройств. Выпускаются в металлическом со стеклянными изоляторами (1Т906А, ГТ906А) и металлопластмассовом (ГТ906АМ) корпусах с жесткими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзисторов 1Т906А, ГТ906А не более 4,5 г (с крепежным фланцем не более 6 г), ГТ906АМ не более 7 г.

1Т906А, ГТ906А



ГТ906АМ



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока	
в схеме ОЭ при $U_{КБ} = 10 \text{ В}$, $I_3 = 5 \text{ А}$:	
$T = +25 \text{ °С}$ для 1Т906А, ГТ906А, ГТ906АМ	30...150
$T = -60 \text{ °С}$ для 1Т906А.....	30...170
$T = +70 \text{ °С}$ для 1Т906А.....	20...150
Граничное напряжение при $I_{з, и} = 5 \text{ А}$, не менее:	
1Т906А при $t_{и} \leq 50 \text{ мкс}$, $Q \geq 2000$	65 В
ГТ906А, ГТ906АМ при $t_{и} \leq 250 \text{ мкс}$, $f = 1...2 \text{ МГц}$	75 В
Напряжение насыщения коллектор—эмиттер при $I_{к, и} = 5 \text{ А}$, $I_{б, и} = 0,5 \text{ А}$, не более:	
$T = +25 \text{ °С}$ для 1Т906А, ГТ906А, ГТ906АМ	0,5 В
$T = -60 \text{ °С}$ для 1Т906А.....	0,5 В
$T = +70 \text{ °С}$ для 1Т906А.....	1 В
Напряжение насыщения база—эмиттер при $I_{к, и} = 5 \text{ А}$, $I_{б, и} = 0,5 \text{ А}$, не более:	
1Т906А	0,6 В
ГТ906А, ГТ906АМ	0,7 В
Время нарастания при $U_{КЭ} = 30 \text{ В}$, $U_{ЭБ} = 0,5 \text{ В}$, $I_{б, и} = 0,5 \text{ В}$, $t_{и} = 20 \text{ мкс}$, $f = 50 \text{ МГц}$, $R_{и} = 6 \text{ Ом}$ для 1Т906А, не более	
	1 мкс
Время включения при $U_{КЭ} = 30 \text{ В}$, $U_{ЭБ} = 0,5 \text{ В}$, $I_{б, и} = 0,5 \text{ В}$, $t_{и} = 20 \text{ мкс}$, $f = 50 \text{ МГц}$, $R_{и} = 6 \text{ Ом}$ для ГТ906А, ГТ906АМ, не более	
	1 мкс
Время рассасывания при $U_{КЭ} = 30 \text{ В}$, $I_{б, и} = 0,5 \text{ В}$, $t_{и} = 20 \text{ мкс}$, $f = 50 \text{ МГц}$, $R_{и} = 6 \text{ Ом}$, не более	
	5 мкс
Обратный ток коллектор—эмиттер при $U_{КБ} = 75 \text{ В}$, $U_{ЭБ} = 0,5 \text{ В}$, не более:	
$T = +25$ и -60 °С для 1Т906А, ГТ906А, ГТ906АМ	8 мА
$T = +70 \text{ °С}$:	
1Т906А.....	15 мА
ГТ906А, ГТ906АМ.....	30 мА
Обратный ток эмиттера при $U_{ЭБ} = 1,4 \text{ В}$, не более:	
1Т906А	8 мА
ГТ906А, ГТ906АМ.....	15 мА

Предельные эксплуатационные данные

Напряжение коллектор—эмиттер:	
1Т906А при $U_{БЭ} = 0,5...1,4$ В.....	75 В
ГТ906А, ГТ906АМ ¹ при $U_{БЭ} = 0,4...1,4$ В.....	75 В
Импульсное напряжение коллектор—эмиттер запертого транзистора при $U_{БЭ} = 0,4...1,4$ В, $t_{и} \leq 20$ мкс, $Q \geq 3$ для ГТ906А, ГТ906АМ	
	130 В
Напряжение коллектор—база	75 В
Напряжение база—эмиттер	1,4 В
Постоянный или импульсный ток коллектора в режиме насыщения ¹	
	10 А
Постоянный ток коллектора в режиме пере- ключения:	
1Т906А	5 А
ГТ906А, ГТ906АМ	6 А
Ток коллектора в режиме переключения:	
1Т906А (при $U_{кэ} \approx 36$ В и выбросах напря- жения до 45 В длительностью до 10 мкс) .	7 А
ГТ906А, ГТ906АМ (при напряжении на коллекторе закрытого транзистора не более 25 В)	7 А
Постоянный или средний ток базы:	
1Т906А (за период не более 2 мс)	1,5 А
ГТ906А, ГТ906АМ при $t_{и} \leq 2$ мс, $Q \geq 3$	1,5 А

¹ Отключение транзистора осуществлять при токе коллектора не более 5 А для 1Т906А и 6 А для ГТ906А, ГТ906АМ.

Постоянная или средняя рассеиваемая мощ- ность коллектора ¹ при $T_k \leq +37,5$ °С	15 Вт
Импульсная рассеиваемая мощность транзи- стора:	
при $t_{и} \leq 10$ мкс	375 Вт
при $t_{и} \leq 200$ мкс, $U_{кэ} \leq 60$ В, $f = 5$ Гц	300 Вт
Тепловое сопротивление переход—корпус	2,5 °С/Вт
Тепловое сопротивление переход—среда	50 °С/Вт
Температура р-п перехода	+75 °С
Температура окружающей среды	-60... $T_k =$ = +70 °С

¹ При $T_K > +37,5$ °С постоянная или средняя рассеиваемая мощность коллектора рассчитывается по формулам

$$P_{K, \text{MAX}} = (75 - T_K) / 25, \text{ Вт},$$

при использовании транзистора с теплоотводом;

$$P_{K, \text{MAX}} = (75 - T) / 50, \text{ Вт},$$

при использовании транзистора без теплоотвода.